

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

メモリ・テスト・システム「T5781/T5781ES」を販売開始

フラッシュ・メモリや DRAM などを混載した MCP 向けに 最高試験速度 266MHz/533Mbps で、高スループットに試験可能なテスト

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:丸山利雄)は、NAND 型フラッシュ・メモリや NOR 型フラッシュ・メモリ、SDRAM などを混載した MCP (Multi Chip Package) 型メモリを最高試験速度 266MHz/533Mbps (DDR モード時) で試験可能なメモリ・テスト・システム「T5781」、および評価・量産プログラム開発用に「T5781ES (エンジニアリング・ステーション)」を開発し、10 月より販売を開始いたしました。

開発の背景

近年、携帯電話には高画質のカメラ機能や音楽プレーヤー機能など様々なアプリケーションが搭載されており、これらに使用されるメモリも大容量化や高機能化、高速化が進んでおります。また、最終製品の小型化にともないデバイスの小サイズ化が進み、メモリを含む複数のデバイスを搭載する MCP が一般的に使用されています。

従来、これら MCP の動作試験を行なうためには、搭載されるフラッシュ・メモリや DRAM などのデバイスに対し、それぞれに適したテストが必要でした。このため複数の工程で試験が行なわれ、テスト・コスト増大の要因となっていました。さらに最近では、MCP に搭載される DRAM などの動作周波数は 100MHz を超えており、デバイスの高速化に対応したテスト・ソリューションが求められています。

新製品の特長

- (1) 最高試験速度 266MHz/533Mbps(DDR モード時)を実現
MCP 向けテストにおける業界最高クラスの試験速度 266MHz/533Mbps(DDR モード時)を実現し、高速 DRAM 試験にも対応します。
- (2) 各種メモリ測定機能を搭載
DRAM やフラッシュ・メモリなど各種メモリの測定機能を搭載しています。複数種のデバイスを搭載する MCP を、この 1 台でかつ 1 パスで効率良く試験することができます。
- (3) パーサイト・アーキテクチャを採用したことにより NAND 型フラッシュ・メモリ試験を効率化
テスト・サイト毎に電源やパターン発生器などの試験リソースを備えておりますので、デバイスを個別に制御して測定することが可能です。このように測定機能を独立化(パーサイト化)させることで、NAND 型フラッシュ・メモリや SPI (Serial Peripheral Interface) フラッシュ・メモリなどのテスト・タイムを劇的に短縮します。



(4) 評価・量産プログラム開発用に T5781ES を同時開発

T5781 の機能、性能をそのまま維持した小型のエンジニアリング・タイプ (T5781ES) を開発しました。デバイスの開発から量産までをシームレスに行なえ、TAT (Turn Around Time) 短縮が可能です。

新製品 T5781/T5781ES の販売により、フラッシュ・メモリや DRAM のウエハ試験から MCP のパッケージ試験にいたるまでお客様に信頼いただける高品質なトータル・ソリューションを提供してまいります。

定 価

メモリ・テスト・システム T5781/T5781ES 24 百万円から (構成により異なる)

販売目標

初年度 40 台 (T5781/T5781ES)

主な仕様

T5781	T5781ES
同時測定個数：最大 512 個	最大 32 個
最大試験速度：266MHz / 533Mbps (DDR モード時)	266MHz / 533Mbps (DDR モード時)
テストヘッド：1 ステーション	1 ステーション

製品に関するお問い合わせ先

営業本部 ATE ソリューションビジネス部 電話:03-3214-7505

* 本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な事象により予告無く変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。